PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-016410

(43)Date of publication of application: 18.01.2002

(51)Int.CI.

H01P 7/10 F16B 19/00 F16B 35/06

(21)Application number: 2000-198547

.(71)Applicant: TDK CORP

(22)Date of filing:

30.06.2000 (72)Inventor: ISHITOBI TOKUMASA

YAMADA TOSHIAKI

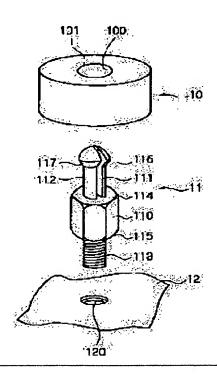
AJIOKA ERIKO ENDO KENJI

(54) DIELECTRIC RESONATOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a dielectric resonator, which can be easily assembled and attached and also can be surely fixed at the time of mounting.

SOLUTION: This device is provided with a dielectric resonance element having a through hole on the center and a supporting means for supporting the dielectric resonance element, the supporting means has a first shoulder part having a lateral length greater than the diameter of the through hole in one part at least and plural elastic locks extended upward from the first shoulder part and protruded outside through the through hole, and each of elastic locks has a downward slope pressing the upside inner edge of the through hole in the outer direction of downward radiation with elasticity. Then, the supporting means is fixed to the dielectric resonance element by elastically holding the dielectric resonance element between the downward slope of each of plural elastic locks and the first shoulder part.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (II) 特許出願公開番号

特開2002-16410 (P2002-16410A) (43)公開日 平成14年1月18日(2002.1.18)

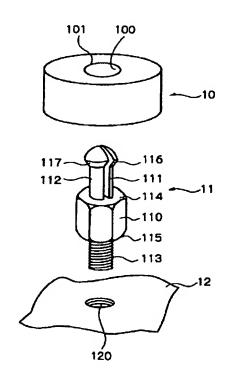
(51) Int. Cl. 7 H 0 1 P F 1 6 B	識別記号 7/10 19/00 35/06		F I H O 1 P F 1 6 B	7/10 19/00 35/06	F G	テーマコート* (参考) 3J036 5J006	
	審査請求 未請求 請求項の数 1]	OL			(全15頁	頁)	
(21) 出願番号						37 ディーケイ株式会社 P央区日本橋1丁目13番1号	
	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(72) 発明者	(72)発明者 石飛 徳昌 東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー ディーケイ株式会社内 (72)発明者 山田 俊昭 東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー ディーケイ株式会社内			
			(72) 発明者				
			(74) 代理人	100074930 弁理士 () 山本 恵一		
						最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】誘電体共振器

(57) 【要約】

【課題】 組み付け及び取り付けが容易であり、実装時 に確実な固定が期待できる誘電体共振器を提供する。

【解決手段】 中央に貫通孔を有する誘電体共振素子 と、誘電体共振素子を支持する支持手段とを備えてお り、支持手段は、貫通孔の径より大きい横方向長さを少 なくとも一部に有する第1の肩部と、第1の肩部から上 方に伸びており貫通孔を挿通して外部に突出している複 数の弾性係止片とを有しており、各弾性係止片は、弾性 によって貫通孔の上側内縁を下向きの放射外方向に押圧 する下向き傾斜面を有しており、支持手段は、複数の弾 性係止片の下向き傾斜面と第1の肩部とによって誘電体 共振素子を弾性挟持することにより誘電体共振素子に固 結されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 中央に貫通孔を有する誘電体共振素子と、該誘電体共振素子を支持する支持手段とを備えており、該支持手段は、前記貫通孔の径より大きい横方向長さを少なくとも一部に有する第1の肩部と、該第1の肩部から上方に伸びており前記貫通孔を挿通して外部に突出している複数の弾性係止片とを有しており、該各弾性係止片は、弾性によって前記貫通孔の上側内縁を下向きの放射外方向に押圧する下向き傾斜面を有しており、前記支持手段は、前記複数の弾性係止片の前記下向き傾斜面と前記第1の肩部とによって前記誘電体共振素子を弾性挟持することにより該誘電体共振素子に固結されていることを特徴とする誘電体共振器。

1

【請求項2】 前記支持手段が、当該誘電体共振器の据付け面に螺着可能な雄ねじ部を同軸に備えていることを 特徴とする請求項1に記載の誘電体共振器。

【請求項3】 前記支持手段が、前記雄ねじ部を螺着した時に前記据付け面に当接してストッパとなる第2の肩部を該雄ねじ部の上側に備えていることを特徴とする請求項2に記載の誘電体共振器。

【請求項4】 前記支持手段が、前記第1の肩部と前記第2の肩部との間に、取り付け工具に係合して該支持手段を軸回転させ前記雄ねじ部を螺着するための工具係合部を備えていることを特徴とする請求項3に記載の誘電体共振器。

【請求項5】 前記工具係合部が、ナット形状を有していることを特徴とする請求項4に記載の誘電体共振器。

【請求項6】 前記第1の肩部及び前記第2の肩部が、前記工具係合部の上面及び下面でそれぞれ構成されていることを特徴とする請求項4又は5に記載の誘電体共振 30 器。

【請求項7】 前記第1の肩部及び前記第2の肩部が、前記工具係合部とは独立して形成されていることを特徴とする請求項4又は5に記載の誘電体共振器。

【請求項8】 前記支持手段が、高周波特性の良好な低 誘電性高分子材料で一体成形されていることを特徴とす る請求項1から7のいずれか1項に記載の誘電体共振 器。

【請求項9】 前記低誘電性高分子材料が、単量体として少なくともフマル酸ジエステルを含む単量体組成物を 40 重合して得られた低誘電性高分子材料であることを特徴とする請求項8に記載の誘電体共振器。

【請求項10】 前記低誘電性高分子材料が、重量平均絶対分子量1000以上の樹脂の1種又は2種以上からなる樹脂組成物であって、その組成物の炭素原子と水素原子の原子数の和が99%以上であり、かつ樹脂分子間の一部又はすべてが相互に化学的結合を有する低誘電性高分子材料であることを特徴とする請求項8に記載の誘電体共振器。

【請求項11】 前記誘電体共振紫子が、セラミック焼 50 台との強固な固結が期待できないものであったり、支持

結体で形成されていることを特徴とする請求項1から1 0のいずれか1項に記載の誘電体共振器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロ波又はミリ波帯域におけるフィルタ、発振器又はアンテナ等に用いられる $TE01\delta$ モードの誘電体共振器に関する。

[0002]

【従来の技術】TE01 δ 誘電体共振素子は、通常、中実の円柱形状又は中央に貫通孔を有する円柱形状で形成されており、その円柱形状の直径は $10\,GHz$ 帯用で約 $4\sim5\,mm$ とかなり小さく、 $60\sim7\,0\,GHz$ 帯用では約 $0.6\sim0.7\,mm$ と著しく小さい。しかも、TE0 1δ 共振素子は、導体等の据付け面から離隔させた状態で固定して実装することが要求される。従って、このような極小のTE0 1δ 誘電体共振素子の実装には特別の工夫が必要となる。

【0003】TE01δ誘電体共振器の実装構造としては種々の公知技術がある。

【0004】共振素子を支持台に組み付ける公知技術として、最も一般的なものは、TE016共振素子を支持台に接着剤、ガラス又はセラミック化学反応等で接着する構造である(実公昭61-41287号公報、実開平5-4607号公報、特開平11-355016号公報)。しかしながら、このような接着による組み付け構造は、接着剤の乾燥等、接着自体に多大の時間を要するので作業性が悪く、共振素子と支持台との位置合わせが難しいので接着作業が非常に困難であり、さらに、再組み付けが不可能である等の多くの問題点を有している。しかも、共振素子の発熱によって接合面に剥離の生じる可能性もある。

【0005】共振素子と支持台とを一体成形する公知技術もある(特開平6-61714号公報、特開平8-222917号公報)。しかしながら、このように共振素子と支持台とを高価なセラミック材料で一体成形することは、多量のセラミック材料を要することから共振器の製造コストを増大させる。また、セラミック材料は、複雑な形状に成形することが難しいため、支持台の形状も限定されてしまう。

【0006】共振素子を支持台に組み付ける他の公知技術として、共振素子の貫通孔に、これと係合する形状の支持台を嵌合させて固結する組み付け構造がある(特開平9-186512号公報、特開平9-186514号公報、特開平9-186515号公報、特開平9-186516号公報、特開平9-186516号公報、特開平9-223907号公報)。しかしながら、これら公知の組み付け構造は、セラミック材料による共振素子に切り溝等の機械加工を要求するものであったり、技振素子と支持会との発用な思熱が概念できないものであったり、共振素子と支持会との発用な思熱が概念できないものであったり、

台の寸法を非常に精密に規定しないと隙間等によって確 実な固定ができないものであったりと問題点をそれぞれ 有している。

【0007】支持台を据付け面に取り付ける公知技術と しては、接着又は1つ以上の一般的なねじを用いて固着 する構造がある(前述した公報)。しかしながら、接着 による取り付け構造は、接着剤の乾燥等、接着自体に多 大の時間を要するので作業性が悪く、共振素子と支持台 との位置合わせが難しいので接着作業が非常に困難であ り、さらに、再取り付けが不可能である等の様々な問題 10 を有している。また、ねじを用いる取り付け構造は、細 かなねじによる固定作業が非常に困難である、部品点数 がそのねじの分だけ増大する、及びそのねじによって支 持台の誘電率が変化してしまうという問題がある。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】以上述べたように公知 の実装構造には、種々の問題点がある。しかも、これら 公知の実装構造は、いずれも10GHz帯用のTE01 δ共振器に関するものであって、60~70GHz帯用 の共振素子径が約0.6~0.7mmという極小のTE 01 δ 共振器には、ほとんどのものが適用できない。

【0009】従って本発明は上述した問題点を解決する ためのものであり、その目的は、組み付け及び取り付け が容易であり、実装時に確実な固定が期待できる誘電体 共振器を提供することにある。

【0010】本発明の他の目的は、60GHz以上の帯 域用の極小の誘電体共振器であっても組み付け及び取り 付けが容易な誘電体共振器を提供することにある。

【0011】本発明のさらに他の目的は、高周波損失特 性の優れた誘電体共振器を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、中央に 貫通孔を有する誘電体共振素子と、誘電体共振素子を支 持する支持手段とを備えており、支持手段は、貫通孔の 径より大きい横方向長さを少なくとも一部に有する第1 の肩部と、第1の肩部から上方に伸びており貫通孔を挿 通して外部に突出している複数の弾性係止片とを有して おり、各弾性係止片は、弾性によって貫通孔の上側内縁 を下向きの放射外方向に押圧する下向き傾斜面を有して おり、支持手段は、複数の弾性係止片の下向き傾斜面と 40 第1の肩部とによって誘電体共振素子を弾性挟持するこ とにより誘電体共振素子に固結されている誘電体共振器 が提供される。

【0013】誘電体共振索子の貫通孔内に支持手段の複 数の弾性係止片を挿入してその頂部を貫通孔の反対側へ 突出させることにより、各係止片の下向き傾斜面が弾性 によって貫通孔の上側内縁を下向きの放射外方向に押圧 する。これによって、誘電体共振案子は、支持手段の複 数の弾性係止片の下向き傾斜面と第1の肩部とによって を弾性挟持され、支持手段と誘電体共振案子との固結が 50

自動的に行われる。共振素子の貫通孔内に支持手段の弾 性係止片を挿通させるだけで固結が自動的に行われるの で、位置合わせも不要であり、極小の誘電体共振素子で あってもその支持手段への組み付けが非常に容易とな る。しかも、各係止片の下向き傾斜面が弾性によって貫 通孔の上側内縁を下向きの放射外方向に押圧するように しているので、係止片の寸法をさほど精密に設定しない 場合でも隙間が発生せず確実なかつ強固な固定が期待で きる。

【0014】支持手段が、誘電体共振器の据付け面に螺 着可能な雄ねじ部を同軸に備えていることが好ましい。 このように、同軸の雄ねじ部を備えているので、極小の 誘電体共振素子であっても極めて容易に実装が行える。 【0015】支持手段が、雄ねじ部を螺着した時に据付 け面に当接してストッパとなる第2の肩部を雄ねじ部の 上側に備えていることも好ましい。

【0016】支持手段が、第1の肩部と第2の肩部との 間に、取り付け工具に係合して支持手段を軸回転させ雄 ねじ部を螺着するための工具係合部を備えていることも 好ましい。本発明の一実施態様においては、この工具係 合部が、ナット形状を有している。

【0017】第1の肩部及び第2の肩部が、工具係合部 の上面及び下面でそれぞれ構成されているか、又は工具 係合部とは独立して形成されていることも好ましい。

【0018】支持手段が、高周波特性の良好な低誘電性 高分子材料で一体成形されていることが好ましい。この 低誘電性高分子材料が、単量体として少なくともフマル 酸ジエステルを含む単量体組成物を重合して得られた低 誘電性高分子材料、又は重量平均絶対分子量1000以 上の樹脂の1種又は2種以上からなる樹脂組成物であっ て、その組成物の炭素原子と水素原子の原子数の和が9 9%以上であり、かつ樹脂分子間の一部又はすべてが相 互に化学的結合を有する低誘電性高分子材料であること がより好ましい。

【0019】このような低誘電性高分子材料は、誘電率 が低くミリ波帯においても損失が小さく、成形が容易で あり、かつ熱膨張係数が小さい。従って、支持手段の成 形にこのような低誘電性高分子材料を用いることによ り、複数の弾性係止片、雄ねじ部及び工具係合部等の複 雑な形状を一体成形で形成でき、しかも熱膨張が少な く、高周波特性の優れた誘電体共振器を提供できるので ある。

【0020】誘電体共振案子が、セラミック焼結体で形 成されていることも好ましい。

[0021]

30

【発明の実施の形態】図1は本発明の一実施形態におけ るTE01δ誘電体共振器の構成を概略的に示す分解斜 視図であり、図2はこの共振器を据付け面に取り付けた 状態の軸断面図である。

【0022】これらの図において、10はTE018モ

ードの共振素子、11はその支持台、12はこの共振器 が取り付けられる据付け面をそれぞれ示している。

【0023】共振素子10は、図1に示すように円柱形 状であるか又は角柱形状に成形された焼結セラミック体 からなっており、その中央には貫通孔100が同軸に形 成されている。この共振器が60~70GHz帯用であ るとすると、共振素子10の外径は約0.6~0.7m m程度となる。

【0024】支持台11は、工具係合部110と、この 工具係合部110から上方に伸長する2つの弾性係止片 111及び112と、この工具係合部110から下方に 同軸に伸長する雄ねじ部113とを可撓性を有する低誘 電性高分子材料によって一体成形することにより構成さ れている。

【0025】工具係合部110は、本実施形態では六角 ナット形状に形成されており、スパナ等の取り付け工具 に係合して支持台11を軸回転させるように構成されて いる。この工具係合部110の上面(ストッパ)114 (本発明の第1の肩部に対応) は、共振素子10の貫通 孔100の内径より大きな外径又は横方向長さを有して おり、その下面(ストッパ)115(本発明の第2の肩 部に対応) は雄ねじ部113の外径より大きな外径又は 横方向長さを有している。

【0026】なお、工具係合部110の形状は、六角ナ ット形状に限定されるものではなく、四角ナット、その 他の角ナット、丸ナット等のナット形状であっても良い し、また、他の取り付け工具に係合して支持台11を軸 回転させるための形状であれば良い。

【0027】2つの弾性係止片111及び112の各々 は、工具係合部110の上面114より上方に伸長して 30 おり、放射外方向及び放射内方向に弾性で撓むように構 成されている。弾性係止片111及び112の頭部に は、共振素子10の貫通孔100に嵌合した際に、弾性 係止片111及び112の放射外方向へ反発する弾性に よって貫通孔100の上側内縁101を下向きかつ放射 外方向に押圧するための下向き傾斜面116及び117 がそれぞれ設けられている。また、弾性係止片111及 び112の先端部分は、その先端の径が貫通孔100の 内径より小さいが、その下方では径が貫通孔100の内 径よりやや大きくなるように設定されている。ただし、 共振素子10の貫通孔100への挿入を容易にするため に、弾性係止片111及び112の先端部分はその頂端 に行くほど放射内方向に向かう滑らかな曲面が形成され ている。

【0028】なお、弾性係止片の数は上述のように2つ に限定されるものではなく、3つ以上であっても良い。 ただし、円周方向に等間隔に配置されていることが望ま

【0029】雄ねじ部113は、据付け面12に形成さ れたねじ孔120に螺合できるように形成されている。

【0030】このような構造を有する支持台11と共振 素子10とを組み付ける場合は、支持台11の2つの弾 性係止片111及び112を共振案子10の貫通孔10

0へ下方から挿入する。

【0031】弾性係止片111及び112の先端の径が 貫通孔100の内径より小さいため、及び弾性係止片1 11及び112の先端部分が滑らかな曲面となっている ため、弾性係止片111及び112は貫通孔100へ容 易に挿入できる。挿入が進むに従って、弾性係止片11 1及び112は、貫通孔100の内面に押されて放射内 方向に撓み、反発する弾性によって貫通孔100の内面 を逆に押圧する。

【0032】弾性係止片111及び112の先端部分に おける最も径の大きい部分が貫通孔100を通り抜け、 反対側に突出すると、弾性係止片111及び112の下 向き傾斜面116及び117が、貫通孔100の上側内 縁101に当接し、これを前述した反発する弾性によっ て下向きかつ放射外方向に押圧する。このため、共振素 子10は、弾性係止片111及び112の下向き傾斜面 116及び117と工具係合部110の上面114との 間で挟まれて自動的にかつ強固に支持固結されることと なる。

【0033】下向き傾斜面116及び117によって下 向きかつ放射外方向に押圧されるので、弾性係止片11 1及び112の寸法をさほど精密に設定する必要はな い。即ち、工具係合部110の上面と下向き傾斜面11 6及び117の下縁との距離~工具係合部110の上面 と下向き傾斜面116及び117の上縁との距離の範囲 に共振素子10の厚みが入るように設定すれば強固な結 合が行える。

【0034】支持台11と共振素子10とを組み付けて なる共振器を据付け面12に取り付けるには、支持台1 1の工具係合部110にスパナ等の取り付け工具を係合 させ、雄ねじ部113をねじ孔120に挿入し、工具係 合部110の下面115が据付け面12に当接して止ま るまで支持台11を軸回転させて螺着する。

【0035】以上述べたように本実施形態によれば、共 振素子10の貫通孔100内に弾性係止片111及び1 12を挿通させるだけで固結が自動的に行われるので、 位置合わせも不要であり、60~70GHz帯用の極小 の誘電体共振素子10であっても支持台11への組み付 けが非常に容易となる。しかも、弾性係止片111及び 112の下向き傾斜面116及び117が弾性によって 貫通孔100の上側内縁101を下向きかつ放射外方向 に押圧するようにしているので、これら係止片の寸法を さほど精密に設定しない場合でも隙間が発生せず確実な かつ強固な固定が期待できる。

【0036】本実施形態で支持台11の一体成形に用い ている低誘電性高分子材料は、単量体として少なくとも 50 フマル酸ジエステルを含む単量体組成物を重合して得ら

れた低誘電性高分子材料(特開平9-208627号公 報参照、以下第1の低誘電性高分子材料)、又は重量平 均絶対分子量1000以上の樹脂の1種又は2種以上か らなる樹脂組成物であって、その組成物の炭素原子と水 素原子の原子数の和が99%以上であり、かつ樹脂分子 間の一部又はすべてが相互に化学的結合を有する低誘電 性高分子材料(特開平11-60645号公報参照、以 下第2の低誘電性高分子材料)であり、①誘電率が低く ミリ波帯においても損失が小さいという優れた高周波特 性を有する、②成形が容易である、③熱膨張係数が小さ い、②接着性が良いという利点を備えている。支持台1 1の成形にこのような低誘電性高分子材料を用いること により、工具係合部110、弾性係止片111及び11 2、並びに雄ねじ部113等の複雑な形状を容易に一体 成形で形成でき、しかも熱膨張が少なく、高周波特性の 優れた誘電体共振器が得られるのである。

【0037】第1の低誘電性高分子材料は単量体として フマル酸ジエステルを含む単量体組成物を重合して得ら れたものであり、フマル酸ジエステルから誘導される繰 り返し単位を有するフマレート系重合体である。

【0038】フマル酸ジエステル単量体としては高分子 材料としたとき、高分子材料に低誘電性や耐熱性を付与 するものであれば特に限定されるものではないが、下記 の式(1)で表される化合物が好ましい。

[0039]
[(£1]
$$R^1$$
— OOC

|
 $CH = CH$
|
 $COO - R^2$

式(1)中、R¹はアルキル基又はシクロアルキル基を 表し、R²はアルキル基、シクロアルキル基又はアリー ル基を表し、R 1 及びR 2 は同一のものでも異なるもの であってもよい。

【0040】R1、R2で表されるアルキル基として は、総炭素数2~12のものが好ましく、直鎖状であっ ても分岐を有するものであってもよく、さらには置換基 を有していてもよい。置換基を有する場合の置換基とし 40 ては、ハロゲン原子(F、C1)、アルコキシ基(メト キシ基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基等)、 アリール基(フェニル基等)などが挙げられる。

【0041】R¹、R²で表されるアルキル基の具体例 としては、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル 基、nープチル基、secープチル基、tertープチ ル基、n-ペンチル基(n-アミル基)、sec-アミ ル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、tert-ペ ンチル基、n-ヘキシル基、4-メチル-2-ペンチル ンデシル基、ドデシル基、トリフルオロエチル基、ヘキ サフルオロイソプロピル基、パーフルオロイソプロピル 基、パーフルオロブチルエチル基、パーフルオロオクチ ルエチル基、2-クロロエチル基、1-プトキシー2-プロピル基、メトキシエチル基、ベンジル基などが挙げ られる。

【0042】R1、R2で表されるシクロアルキル基と しては、総炭素数3~14のものが好ましく、単環であ っても橋かけ環を有するものであってもよく、さらには 置換基を有していてもよい。この場合の置換基としては 上記のアルキル基のところで例示したものと同様のもの であってよく、このほかアルキル基(メチル基等の炭素 数1~14の直鎖あるいは分岐のもの) などを挙げるこ とができる。

【0043】R1、R2で表されるシクロアルキル基の 具体例としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル 基、アダマンチル基、ジメチルアダマンチル基などが挙 げられる。

【0044】R2で表されるアリール基としては、総炭 素数6~18のものが好ましく、単環が好ましいが多環 (縮合環ないし環集合)であってもよく、置換基を有し ていてもよい。この場合の置換基は、アルキル基、シク ロアルキル基のところで例示したものと同様のものが挙 げられる。

【0045】R2で表されるアリール基の具体例として は、フェニル基等が挙げられる。

【0046】R¹、R²としては、アルキル基、シクロ アルキル基が好ましい。アルキル基としては、分岐を有 するアルキル基が好ましく、イソプロピル基、sec-30 ブチル基、tert‐ブチル基などが好ましい。また、 シクロアルキル基としてはシクロヘキシル基などが好ま

【0047】式(1)で表されるフマル酸ジエステル単 量体の好適例として、具体的にはジエチルフマレート、 ジーnープロピルフマレート、ジーnーヘキシルフマレ ート、イソプロピル-n-ヘキシルフマレート、ジイソ プロピルフマレート、ジーn-ブチルフマレート、ジー secープチルフマレート、ジーtertープチルフマ レート、ジーsec-アミルフマレート、n-プチル-イソプロピルフマレート、イソプロピル-sec-ブチ ルフマレート、tert-ブチル-4-メチル-2-ペ ンチルフマレート、イソプロピルーtert-プチルフ マレート、イソプロピルーsec-アミルフマレート、 ジー4-メチル-2-ペンチルフマレート、ジーイソア ミルフマレート、ジー4-メチル-2-ヘキシルフマレ ート、tert-プチル-イソアミルフマレート等のジ アルキルフマレート類;ジシクロペンチルフマレート、 ジシクロヘキシルフマレート、ジシクロヘプチルフマレ ート、シクロペンチルーシクロヘキシルフマレート、ビ 基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウ 50 ス(ジメチルアダマンチル)フマレート、ピス(アダマ

30

ンチル) フマレート等のジシクロアルキルフマレート 類;イソプロピルーシクロヘキシルフマレート、イソプ ロピルージメチルアダマンチルフマレート、イソプロピ ルーアダマンチルフマレート、tert-ブチルーシク ロヘキシルフマレート等のアルキルシクロアルキルフマ レート類;イソプロピル-フェニルフマレート等のアル キルアリールフマレート類; tertープチルペンジル フマレート、イソプロピルーベンジルフマレート等のア ルキルアラルキルフマレート類:ジトリフルオロエチル フマレート、ジヘキサフルオロイソプロピルフマレー ト、ジパーフルオロイソプロピルフマレート、ジパーフ ルオロブチルエチルフマレート等のジーフルオロアルキ ルフマレート類;イソプロピルーパーフルオロオクチル エチルフマレート、イソプロピルーヘキサフルオロイソ プロピルフマレート等のアルキルフルオロアルキルフマ レート類: 1-プトキシ-2-プロピルーtertーブ チルフマレート、メトキシエチルーイソプロピルフマレ ート、2-クロロエチルーイソプロピルフマレート等の その他の置換アルキルアルキルフマレート類などが挙げ られる。

【0048】なかでも、ジイソプロピルフマレート、ジシクロヘキシルフマレート、ジ-sec-ブチルフマレート、ジ-tert-ブチルフマレート、イソプロピルーtert-ブチルフマレート、n-ブチルーイソプロピルフマレート、n-ヘキシルーイソプロピルフマレートなどが特に好ましい。

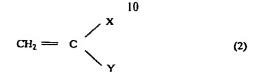
【0049】これらのジエステル類は通常のエステル化技術及び異性化技術を組み合わせることにより、合成することができる。

【0050】高分子材料であるフマレート系重合体を得るに際し、上述したフマル酸ジエステル(フマレート系化合物)は1種のみを用いてもよく、2種以上を併用してもよい。従って、フマレート系重合体としては上述のフマル酸ジエステルを1種のみ重合した単独重合体であってもよく、2種以上を重合した共重合体であってもよい。共重合体はランダム共重合体、交互共重合体、ブロック共重合体等のいずれであってもよい。

【0051】フマレート系重合体は、このように、フマル酸ジエステルのみを単量体成分に用いたものであってもよいが、フマル酸ジエステルのほかに他の単量体を用いることができ、他の単量体成分との共重合体とすることができる。このような他の単量体成分としてはビニル系単量体(モノマー)を用いればよく、コモノマーとされるビニル系単量体としては、成形加工性、フィルム成膜性、機械的強度を付与することができ、前記フマレート系化合物と共重合しうるものであれば特に限定されるものではないが、好ましくは下記の式(2)で表される化合物を挙げることができる。

[0052]

【化2】



式(2)について説明すると、Xは水素原子又はメチル基を表し、Yはフッ素原子、塩素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、エーテル基、アシル基又はエステル基を表す。

【0053】Yで表されるアルキル基としては、総炭素 10 数1~14のものが好ましく、直鎖状であっても分岐を 有するものであってもよい。

【0054】Yで表されるアルケニル基としては、総炭素数2~14のものが好ましく、直鎖状であっても分岐を有するものであってもよく、さらには置換基を有していてもよく、例えばビニル基、アリル基、プロベニル基、ブテニル基等が挙げられる。

【0055】Yで表されるアリール基としては、総炭素数6~18のものが好ましく、単環であっても縮合環等の多環であってもよく、さらにはハロゲン原子(F、C1)、アルキル基(メチル基等)の置換基を有していてもよい。具体的には、フェニル基、 α ーナフチル基、 β ーナフチル基、(α -ナフチル基、(α -、 α -カフチル基、(α -ナフチル基、(α -カフチル基、(α -カフチル基、(α -カフチル基、(α -カフチル基、(α -カフチル基、(α -カフチル基等が挙げられる。

【0056】 Yで表されるエーテル基は、-OR³で示され、この場合のR³としてはアルキル基、アリール基等が挙げられる。R³で表されるアルキル基としては総炭素数が $1\sim8$ であるものが好ましく、直鎖状であっても分岐を有するものであってもよく、さらには置換基

(ハロゲン原子等)を有していてもよい。R³で表されるアリール基としては総炭素数6~18のものが好ましく、単環が好ましいが縮合環等の多環であってもよい。【0057】Yで表されるエーテル基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、フェノキシ基等が挙げられる。

【0058】Yで表されるアシル基は-COR *で示され、この場合のR *としてはアルキル基、アリール基等が挙げられる。R *で表されるアルキル基としては総炭素数1~8であるものが好ましく、直鎖状であっても分岐を有するものであってもよく、さらには置換基(ハロゲン原子等)を有していてもよい。R *で表されるアリール基としては総炭素数6~18のものが好ましく、単環が好ましいが縮合環等の多環であってもよい。

【0059】Yで表されるアシル基としては、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、ベンゾイル基等が挙げられる。

【0060】Yで表されるエステル基は、-OCOR⁵ 又はCOOR⁵で示され、この場合のR⁵としてはアルキル基、アリール基等が挙げられる。R⁵で表されるアルキル基としては総炭素数が1~20であるものが好ま 50 しく、直鎖状であっても分岐を有するものであってもよ

く、さらには置換基(ハロゲン原子等)を有していてもよい。 R 5 で表されるアリール基としては総炭素数 6 ~ 18のものが好ましく、単環が好ましいが縮合環等の多環であってもよい。

【0061】Yで表されるエステル基としては、アセトキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、イソブチリルオキシ基、バレリルオキシ基、イソバレリルオキシ基、 $-OCOC_4H_9$ (-sec)、 $-OCOC_4H_9$ (-sec)、 $-OCOC_4H_9$ (-tert)、 $-OCOC(CH_3)_2CH_2$ CH₃、 $-OCOC(CH_3)_2CH_2$ CH₃、ステアロイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、tert-ブチルベンゾイルオキシ基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、フェノキシカルボニル基等が挙げられる。

【0062】共重合成分とはオレフィン系炭化水素を主 体とするピニル系コモノマーであり、式(2)で表され るビニル系モノマーとしては、例えば酢酸ビニル、ピバ リン酸ピニル、2,2-ジメチルブタン酸ピニル、2, 2-ジメチルペンタン酸ビニル、2-メチル-2-ブタ ン酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ステアリン酸ビニ ル、2-エチル-2-メチルプタン酸ビニル等のカルボ ン酸ピニル類;p-tert-ブチル安息香酸ピニル、 ·N、N-ジメチルアミノ安息香酸ビニル、安息香酸ビニ ル等の芳香族ピニル系単量体類;スチレン、o-, m -, p-クロロメチルスチレン、αーメチルスチレン及 びその核置換体などのα-置換スチレン誘導体類: o -、m-、p-メチルスチレン等のアルキル核置換スチ レン類;塩化ビニル、フッ化ビニル等のαーオレフィン 類;pークロロスチレン等のoー、mー、pーハロゲン 化スチレン等のハロゲン核置換スチレン: エチルビニル エーテル、ピニルブチルエーテル、イソブチルピニルエ ーテル等のビニルエーテル類; $\alpha - \kappa \beta - ビニルナフタ$ レン等のナフタレン誘導体;メチルピニルケトン、イソ プチルピニルケトン等のアルキルビニルケトン類; ブタ ジエン、イソプレン等のジエン類:メチル(メタ)アク リレート、エチル(メタ)アクリレート、ブチル(メ タ) アクリレート、2-エチルヘキシル (メタ) アクリ レート、フェニル (メタ) アクリレート等の (メタ) ア クリル酸エステル類等の公知のラジカル重合成モノマー 40 等を好ましく挙げることができる。

【0063】このようなピニル系モノマーを製造するには、例えば酢酸ビニルと相当する有機酸とのエステル交換反応を酢酸水銀又は硫酸等の存在下で行うか、他の触媒、例えば白金、ロジウム等の金属錯体、触媒の存在下反応を行うことにより容易に合成することができる。

【0064】このようなピニル系モノマーはコモノマー として1種のみを用いても2種以上を併用してもよい。

【0065】また、このようなピニル系モノマーから誘導される繰り返し単位を有するフマレート系重合体は共 50

重合体であるが、ランダム共重合体、交互共重合体、ブロック共重合体等のいずれであってもよい。

【0066】フマル酸ジエステルから誘導される繰り返し単位を有する高分子材料は低誘電性であり、成膜性、膜密着性、さらには機械的物性等の点で優れる。このような高分子材料は、前述のように、同一のフマル酸ジエステルのみを用いた単独重合体、フマル酸ジエステル同士の共重合体、フマル酸ジエステルとこれと共重合可能な他のビニル系単量体との共重合体のいずれであってもよい。

【0067】また、フマレート系重合体の分子量は特に限定はされないが、機械的強度を高めるためには高分子 量体のものが望ましく、数平均分子量で、10000~ 150000であることが好ましい。

【0068】高分子材料は、単量体成分として、上述したようなフマル酸ジエステルのみを実質的に含有する単量体組成物を重合するか、あるいはさらに単量体成分として前記のようなビニル系単量体を含有させた単量体組成物を重合する等して得られたものである。

1 【0069】この場合、フマル酸ジエステルは原料となる単量体(原料モノマー)全体の50重量%以上、さらには60重量%以上、特に80重量%以上であることが好ましい。フマル酸ジエステル量が少なくなると、電気特性(誘電率及び低誘電損失正接)、ならびに耐熱性等が不十分となり好ましくない。

【0070】一方、ピニル系単量体の原料モノマー全体に対する割合は、低誘電性(低誘電率、低誘電正接)、成形加工性、溶液粘度、膜密着性、さらには機械的物性等の点から $0\sim50$ 重量%が好ましく、さらに好ましくは $0\sim40$ 重量%、特に好ましくは $0\sim20$ 重量%である。

【0071】このようなフマレート系重合体中のフマル酸ジエステルに由来する構成成分は好ましくは50重量%以上、特に好ましくは60重量%以上、特に好ましくは80重量%以上である。

【0072】以下に、好ましく用いられるフマレート系 重合体を例示する。重合体は原料モノマーで示すものと する。

【0073】1)ジーアルキルフマレート系

) I-1 ジーイソプロピルフマレート

I-2 ジーシクロヘキシルフマレート

I-3 ジ-sec-ブチルフマレート

I-4 ジーtert-ブチルフマレート

I-5 tert-ブチルーイソプロピルフマレート

I-6 ジーイソプロピルフマレート/ジーsec-ブ チルフマレート

I-7 tert-ブチルーイソプロピルフマレート/ ジーイソプロピルフマレート

I-8 ジーイソプロビルフマレート/ジーシクロヘキ シルフマレート

30

I-9 ジーイソプロピルフマレート/n-ブチルーイソプロピルフマレート

I-10 ジーイソプロピルフマレート/n-ヘキシルーイソプロピルフマレート

I-II ジーシクロヘキシルフマレート/n-ブチルーイソプロピルフマレート

I-I2 ジーシクロヘキシルフマレート/ジーsec-ブチルフマレート

【0074】II)ジーアルキルフマレート/ビニル系 II-1 ジーイソプロピルフマレート/スチレン

II-2 ジーsecープチルフマレート/tertープチル安息香酸ピニル

II-3 ジーシクロヘキシルフマレート/2-エチルー 2-メチルプタン酸ビニル

II-4 ジーイソプロピルフマレート/tertーブチル安息香酸ビニル

II-5 ジーイソプロピルフマレート/p-N, N-ジメチルアミノ安息香酸ビニル

II-6 ジーシクロヘキシルフマレート/tertーブ チル安息香酸ビニル

II-7 シクロヘキシル-イソプロピルフマレート/酢酸ビニル

II-10 ジーイソプロピルフマレート/ジーsec-ブ チルフマレート/N, N-ジメチルアミノ安息香酸ビニ ル

II-II ジーsecーブチルフマレート/ジーシクロヘキシルフマレート/tertーブチル安息香酸ビニルII-I2 ジーシクロヘキシルフマレート/ジーイソプロピルフマレート/スチレン

【0075】このフマレート系重合体を製造するには、 通常のラジカル重合法を好ましく用いることができる。 重合に際し用いられる重合開始剤としては、分子量を上 げるため10時間半減期温度が80℃以下の有機過酸化 物及びアゾ化合物の1種又は2種以上を好ましく用いる ことができる。このような重合開始剤として、例えば過 40 酸化ペンゾイル、ジイソプロピルペルオキシジカーボネ ート、tert-プチルペルオキシジ-2-エチルヘキ サノエート、tertープチルペルオキシジイソプチレ ート、クメンパーオキサイド、tert-ブチルヒドル パーオキシド、tertーブチルペルオキシピパレー ト、過酸化ラウロイルジアシルパーオキシド等の有機過 酸化物、2,2'-アゾビスプチロニトリル、2,2' **-アゾピス(2-メチルプチロニトリル)、アゾビス** (2, 4-ジメチルパレロニトリル)、1, 1'-アゾ ピス (シクロヘキサン-1-カルポニトリル)、2,

....

2'-アゾビス(イソ酪酸)ジメチル、2,2'-アゾビス(2,4-ジメチルパレロニトリル)、tert-ブチルペルオキシイソプロピルカーボネート等のアゾ系化合物が挙げられる。重合開始剤の使用量としては原料モノマー100重量部に対して10重量部以下が好ましく、さらに好ましくは5重量部以下である。

14

【0076】また、このような調製法において各モノマーを重合ないし共重合させる際の条件としては、適時重合系を不活性ガス、例えば窒素、二酸化炭素、ヘリウム、アルゴン等で置換ないしは雰囲気下、あるいは脱気条件下で重合させることが好ましい。重合ないし共重合させる際の温度としては使用する重合開始剤の種類により異なるが、30℃~120℃の範囲が好ましい。また、重合に要する全時間は、10時間~72時間程度であることが望ましい。また、原料モノマーに色素等の着色あるいは紫外線吸収剤等の添加物を加えて重合させることも可能である。

【0077】ラジカル重合法としては、溶液重合、塊状 重合、乳化重合、懸濁重合、放射線重合等の汎用のビニ ル系モノマーのラジカル重合に用いられる数多くの重合 法により行うことができる。高周波帯域用の用途におい て、低誘電損失正接を極めて低くすることが重要なポイ ントとなる。高分子材料中の低分子量体の存在が外部可 塑化を引き起こし誘電損失正接を大きくし、高周波帯域 における誘電特性を悪化する要因となるため、フマレー ト系重合体及び共重合体の分子量が極めて高くなるよう な重合方法をとることが重要であり、仕込みモノマーの 濃度を高くすることができる、例えば共重合させる際の 仕込みモノマーであるフマル酸ジエステルと、ビニル系 モノマーとの両モノマーの濃度を十分高くすることがで きる塊状重合法あるいは懸濁重合法が最も望ましい。ま た重合温度は高くなるにつれて重合体ないし共重合体の 分子量が小さくなるので、例えば0℃から60℃の低温 にてラジカル重合ないし共重合させるのが好ましい。

【0078】この高分子材料を所定の形状に成形して用いる場合は、キャスティング法で種々の型を用いて棒状、角状、円柱状とすることができる。この際フマレート系重合体溶液の注入は必要に応じ加圧しながら行ってもよい。このほかの成形方法としてはモールディング法、コンプレッション法、押し出し法などが挙げられ、公知の方法に準じ、フマレート系重合体を含む溶液、ベーストあるいはバテなどを用い、型にこれらを注入するなどして行えばよい。

【0079】第2の低誘電性高分子材料は、重量平均絶対分子量が1000以上の1種又は2種以上の樹脂で構成される樹脂組成物であって、炭素原子と水素原子の原子数の和が99%以上からなり、かつ樹脂分子間の一部又はすべてが相互に化学的結合しているものである。このような重量平均絶対分子量の樹脂組成物とすることによって、低誘電性高分子材料として用いるときの強度、

金属との密着性、耐熱性が十分になる。これに対し、重量平均絶対分子量が1000より小さいと、機械的物性、耐熱性等が不足になり不適である。特に好ましくは3000以上、最も好ましくは5000以上である。このときの重量平均絶対分子量の上限に特に制限はないが、通常1000万程度である。

【0080】また、この樹脂組成物において炭素と水素と原子数の和を99%以上とするのは、存在する化学的結合を非極性結合とするためであり、これにより耐熱性低誘電性高分子材料として用いるときの電気的特性が十分になる。これに対し、炭素と水素の原子数の和が99%より少ない場合、特に酸素原子や、窒素原子などの有極性分子を形成する原子数が1%より多く含まれる場合、電気的特性、特に誘電正接が高くなるため不適である。

【0081】この高分子材料を構成する樹脂の具体例と しては、低密度ポリエチレン、超低密度ポリエチレン、 超超低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、低分子 量ポリエチレン、超高分子量ポリエチレン、エチレンー プロピレン共重合体、ポリプロピレン、ポリプテン、ポ リ4ーメチルペンテン等の非極性αーオレフィンの単独 ないし共重合体[以下、(共)重合体ともいう]、ブタ ジエン、イソプレン、ペンタジエン、ヘキサジエン、ヘ プタジエン、オクタジエン、フェニルブタジエン、ジフ エニルプタジエン等の共役ジエンの各単量体の(共)重 合体、スチレン、核置換スチレン、例えばメチルスチレ ン、ジメチルスチレン、エチルスチレン、イソプロピル スチレン、クロルスチレン、α-置換スチレン、例えば α – メチルスチレン、 α – エチルスチレン、ジビニルベ ンゼン、ビニルシクロヘキサン等の炭素環含有ビニルの 30 各単量体の(共) 重合体等が挙げられる。

【0082】上記では、非極性αーオレフィンの単量体同士、共役ジエンの単量体同士、炭素環含有ビニルの単量体同士の重合体を主に例示したが、例えば非極性αーオレフィンの単量体と共役ジエンの単量体、非極性αーオレフィンの単量体と炭素環含有ビニルの単量体のように、異なる化合物種の単量体から得られた共重合体であってもよい。

【0083】このように、これらの重合体、すなわち樹脂の1種又は2種以上により樹脂組成物が構成されるが、これらの樹脂分子間の一部又はすべてが相互に化学的結合をしていなければならない。従って、一部は混合状態であってもよい。このように少なくとも一部に化学的結合を有することによって耐熱性低誘電性高分子材料として用いるときの強度、金属との密着性、耐熱性が十分になる。これに対し、単なる混合で、化学的結合を有しないときは、耐熱性、機械的物性の観点から不十分である。

【0084】化学的結合の形態は特に限定はないが、架 橋構造、ブロック構造、グラフト構造などが挙げられ る。このような化学的結合を生じさせるには公知の方法によればよく、グラフト構造、ブロック構造の好ましい態様については後述する。架橋構造を生じさせる具体的方法としては、熱による架橋が好ましく、このときの温度は50~300℃程度が好ましい。このほか電子線照射による架橋等も挙げられる。

【0085】樹脂組成物としては、まず、非極性α-オレフィン系重合体セグメントとビニル芳香族系共重合体セグメントとが化学的に結合した共重合体であって、一方のセグメントにより形成された分散相が他方のセグメントより形成された連続相中に微細に分散している多相構造を示す熱可塑性樹脂が好ましいものとして挙げられる。

【0086】上記のような特定の多相構造を示す熱可塑性樹脂中のセグメントの一つである非極性 α ーオレフィン系重合体とは、高圧ラジカル重合、中低圧イオン重合等で得られる非極性 α ーオレフィン単量体の単独重合体又は2種類以上の非極性 α ーオレフィン単量体の共重合体でなければならない。極性ビニル単量体との共重合体は誘電正接が高くなるため不適である。上記重合体の非極性 α ーオレフィン単量体としてはエチレン、プロピレン、ブテン-1、ヘキセン-1、オクテン-1、4ーメチルペンテン-1類が挙げられ、なかでもエチレン、プロピレン、プテン-1、4ーメチルペンテン-1が、得られる非極性 α ーオレフィン系重合体の誘電率が低いため好ましい。

【0087】上記非極性 α - λ -

【0089】一方、特定の多相構造を示す熱可塑性樹脂中のセグメントの一つであるであるビニル芳香族系重合体とは、非極性のものであり、具体的には、スチレン、核置換スチレン、例えばメチルスチレン、ジメチルスチレン、エチルスチレン、イソプロピルスチレン、クロルスチレン、 α - 置換スチレン、例えば α - メチルスチレン、 α - 工チルスチレン、 α - エチルスチレン、 α - エチルスチレン、 α - エチルスチレン、 α - エチルスチレン、 α - ボー、 α - アージビニルベンゼン(好ましくは α - デビニルベンゼン)等の各単量体の

(共) 重合体である。このように非極性のものとするのは、極性官能基を持った単量体を共重合で導入すると、50 誘電正接が高くなるため不適であるからである。ピニル

芳香族系重合体は単独で使用することも、2種以上併用 することもできる。

【0090】なかでもピニル芳香族系共重合体は、ジビニルベンゼンの単量体を含むピニル芳香族共重合体が耐熱性を向上させる上で好ましい。ジピニルベンゼンを含むピニル芳香族共重合体とは、具体的には、スチレン、核置換スチレン、例えばメチルスチレン、ジメチルスチレン、エチルスチレン、イソプロピルスチレン、クロルスチレン、αー置換スチレン、例えばαーメチルスチレン、αーエチルスチレン等の各単量体とジピニルベンゼ 10ンの単量体の共重合体である。

【0091】ジビニルベンゼンの単量体と、これ以外の上記のようなビニル芳香族の単量体との割合は特に限定はないが、半田耐熱性を満足するために、ジビニルベンゼンの単量体の割合が1重量%以上含まれていることが好ましい。ジビニルベンゼンの単量体は100重量%でもかまわないが、合成上の問題から上限は90重量%が好ましい。

【0092】このような一方のセグメントであるビニル 芳香族系重合体の分子量は、重量平均絶対分子量で10 00以上であることが好ましい。この上限には特に制限 はないが、1000万程度である。

【0093】特定の多相構造を示す熱可塑性樹脂は、オレフィン系重合体セグメントが $5\sim95$ 重量%、好ましくは $40\sim90$ 重量%、最も好ましくは $50\sim80$ 重量%からなるものである。従って、ビニル系重合体セグメントは $95\sim5$ 重量%、好ましくは $60\sim10$ 重量%、最も好ましくは $50\sim20$ 重量%である。

【0094】オレフィン系重合体セグメントが少なくなると、成形物が脆くなるため好ましくない。また、オレフィン系重合体セグメントが多くなると、金属との密着性が低く好ましくない。

【0095】このような熱可塑性樹脂の重量平均絶対分子量は1000以上である。この上限には特に制限はないが、成形性の点から1000万程度である。

【0096】オレフィン系重合体セグメントとビニル系 重合体セグメントとが化学的に結合した構造の共重合体 としては具体的にはブロック共重合体やグラフト共重合* *体を例示することができる。なかでも製造の容易さから グラフト共重合体が特に好ましい。なお、これらの共重 合体にはブロック共重合体、グラフト共重合体等の特徴 を逸脱しない範囲で、オレフィン系重合体やビニル系重 合体が含まれていてもかまわない。

【0097】特定の多相構造を示す熱可塑性樹脂を製造する方法は、グラフト化法として一般によく知られている連鎖移動法、電離性放射線照射法等いずれの方法によってもよいが、最も好ましいのは、下記に示す方法によるものである。なぜならグラフト効率が高く熱による二次的凝集が起こらないため、性能の発現がより効果的であり、また製造方法が簡便であるためである。

【0098】特定の多相構造を示す熱可塑性樹脂である グラフト共重合体の製造方法を具体的に詳述する。すな わち、オレフィン系重合体100重量部を水に懸濁させ て、別にビニル芳香族系単量体5~400重量部に、下 記一般式(3)又は(4)で表されるラジカル重合性有 機過酸化物の1種又は2種以上の混合物を上記ビニル単 量体100重量部に対して0:1~10重量部と、10 時間の半減期を得るための分解温度が40~90℃であ るラジカル重合開始剤をビニル単量体とラジカル重合性 有機過酸化物との合計100重量部に対して0.01~ 5 重量部とを溶解させた溶液を加え、ラジカル重合開始 剤の分解が実質的に起こらない条件で加熱し、ビニル単 量体、ラジカル重合性有機過酸化物及びラジカル重合開 始剤をオレフィン系重合体に含浸させて、この水性懸濁 液の温度を上昇させ、ビニル単量体とラジカル重合性有 機過酸化物とをオレフィン共重合体中で共重合させて、 グラフト化前駆体を得る。

【0099】ついでグラフト化前駆体を100~300 ℃の溶融下、混練することにより、このグラフト共重合 体を得ることができる。このとき、グラフト化前駆体 に、別にオレフィン系重合体又はピニル系重合体を混合 し、溶融下に混練してもグラフト共重合体を得ることが できる。最も好ましいのはグラフト化前駆体を混練して 得られたグラフト共重合体である。

[0100] [化3]

(3)

一般式 (3) 中、R」は水素原子又は炭素数 $1 \sim 2$ のアルキル基を示し、R2 は水素原子又はメチル基を示し、R3及びR2はそれぞれ炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基を示し、R5は炭素数 $1 \sim 1$ 2 のアルキル基、フェニル基、

アルキル置換フェニル基又は炭素数 $3 \sim 12$ のシクロアルキル基を示す。 m_1 は 1 又は 2 である。

[0101]

【化4】

(4)

一般式(4)中、R 6 は水素原子又は炭素数1~4のア ルキル基を示し、Rっは水素原子又はメチル基を示し、 Ra及びRaはそれぞれ炭素数1~4のアルキル基を示 10 し、R10は炭素数1~12のアルキル基、フェニル 基、アルキル置換フェニル基又は炭素数3~12のシク ロアルキル基を示す。m2は0、1又は2である。

【0102】一般式(3)で表されるラジカル重合性有 機過酸化物として、具体的には、 t - ブチルペルオキシ アクリロイロキシエチルカーボネート: t-アミルペル オキシアクリロイロキシエチルカーポネート: t - ヘキ シルペルオキシアクリロイロキシエチルカーボネート: 1, 1, 3, 3-テトラメチルプチルベルオキシアクリ ロイロキシエチルカーボネート;クミルペルオキシアク リロイロキシエチルカーポネート; p-イソプロピルク ミルペルオキシアクリロイロキシエチルカーボネート; t-ブチルペルオキシメタクリロイロキシエチルカーボ ネート; t-アミルペルオキシメタクリロイロキシエチ ルカーボネート; t - ヘキシルペルオキシメタクリロイ ロキシエチルカーボネート; 1, 1, 3, 3ーテトラメ チルプチルペルオキシメタクリロイロキシエチルカーボ ネート; クミルペルオキシメタクリロイロキシエチルカ ーポネート;p-イソプロピルクミルペルオキシメタク リロイロキシエチルカーポネート; t ープチルペルオキ シメタクリロイロキシエチルカーポネーボネート: t-アミルペルオキシアクリロイロキシエトキシエチルカー · ポネート; t - ヘキシルペルオキシアクリロイロキシエ トキシエチルカーポネート;1,1,3,3ーテトラメ チルプチルペルオキシアクリロイロキシエトキシエチル カーポネート; クミルペルオキシアクリロイロキシエト キシエチルカーポネート; p-イソプロピルクミルペル オキシアクリロイロキシエトキシエチルカーボネート; t-プチルペルオキシメタクリロイロキシエトキシエチ ルカーボネート; t-アミルペルオキシメタクリロイロ 40 キシエトキシエチルカーボネート: t-ヘキシルペルオ キシメタクリロイロキシエトキシエチルカーポネート; 1, 1, 3, 3-テトラメチルプチルペルオキシメタク リロイロキシエトキシエチルカーポネート:クミルペル オキシメタクリロイロキシエトキシエチルカーポネー ト;p-イソプロピルクミルペルオキシメタクリロイロ キシエトキシエチルカーポネート; t ープチルペルオキ シアクリロイロキシイソプロピルカーポネート; t-ア ミルペルオキシアクリロイロキシイソプロピルカーボネ ート; t - ヘキシルペルオキシアクリロイロキシイソプ 50 オキシメタクリロイロキシエチルカーボネート; ť - ブ

ロピルカーボネート;1,1,3,3-テトラメチルブ チルペルオキシアクリロイロキシイソプロピルカーポネ -ト:クミルペルオキシアクリロイロキシイソプロピル カーポネート; pーイソプロピルクミルペルオキシアク リロイロキシイソプロピルカーポネート: t - ブチルベ ルオキシメタクリロイロキシイソプロピルカーボネー ト; t-アミルペルオキシメタクリロイロキシイソプロ ピルカーボネート; t-ヘキシルペルオキシメタクリロ イロキシイソプロピルカーボネート;1,1,3,3-テトラメチルプチルペルオキシメタクリロイロキシイソ プロピルカーボネート; クミルペルオキシメタクリロイ ロキシイソプロピルカーボネート; p-イソプロピルク ミルペルオキシメタクリロイロキシイソプロピルカーボ ネート等を例示することができる。

【0103】さらに、一般式(4)で表される化合物と しては、t-プチルペルオキシアリルカーボネート; t -アミルペルオキシアリルカーポネート; t - ヘキシル ペルオキシアリルカーボネート; 1, 1, 3, 3ーテト ラメチルプチルペルオキシアリルカーボネート:p-メ ンタンペルオキシアリルカーボネート: クミルペルオキ シアリルカーポネート; t ープチルペルオキシメタリル カーボネート; tーアミルペルオキシメタリルカーボネ -ト; t-ヘキシルペルオキシメタリルカーボネート; 1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルペルオキシメタリ ルカーボネート; p-メンタンペルオキシメタリルカー ポネート;クミルペルオキシメタリルカーポネート; t -プチルペルオキシアリロキシエチルカーボネート: t -アミルペルオキシアリロキシエチルカ-ボネ-ト; t - ヘキシルペルオキシアリロキシエチルカーボネート: t ープチルペルオキシメタリロキシエチルカーポネー ト; t-アミルペルキシメタリロキシエチルカーボネー ト; t-ヘキシルペルオキシメタリロキシエチルカーボ ネート; tープチルペルオキシアリロキシイソプロピル カーポネート; tーアミルペルオキシアリロキシイソプ ロピルカーボネート; t-ヘキシルペルオキシアリロキ シイソプロピルカーボネート: t ーブチルペルオキシメ タリロキシイソプロピルカーボネート; t-アミルペル オキシメタリロキシイソプロピルカーボネート:t-へ キシルペルオキシメタリロキシイソプロピルカーボネー ト等を例示することができる。

【0104】中でも好ましくは、tープチルペルオキシ アクリロイロキシエチルカーポネート;tープチルペル

チルベルオキシアリルカーボネート; t ープチルベルオ キシメタリルカーボネートである。

【0105】このようにして得られるグラフト共重合体のグラフト効率は20~100重量%である。グラフト効率はグラフト化していない重合体の溶媒抽出を行い、その割合から求めることができる。

【0106】特定の多相構造を示す熱可塑性樹脂としては、上記の非極性 α ーオレフィン系重合体セグメントとピニル芳香族系重合体セグメントとのグラフト共重合体が好ましいが、このようなグラフト共重合体において、非極性 α ーオレフィン系重合体セグメントのかわりに、あるいはこれに加えて非極性共役ジエン系重合体セグメントを用いたものであってもよい。非極性共役ジエン系重合体としては、前述のものを用いることができ、単独で使用しても2種以上を併用してもよい。

【0107】なお、以上のグラフト共重合体における非極性 α -オレフィン系重合体には共役ジエン単量体が含まれていてもよく、非極性共役ジエン系重合体には α -オレフィンの単量体が含まれていてもよい。

【0108】また、得られたグラフト共重合体にさらに 20 ジビニルベンゼン等を用いて架橋することもできる。特に、ジビニルベンゼンの単量体を含まないグラフト共重合体において、耐熱性向上の観点から好ましい。

【0109】一方、特定の多相構造を示す熱可塑性樹脂としては、ブロック共重合体であってもよく、ブロック共重合体としては、少なくとも1つのビニル芳香族単量体の重合体と、少なくとも1つの共役ジエンの重合体とを含むブロック共重合体を挙げることができ、直鎖型であっても、ラジアル型、すなわちハードセグメントとソフトセグメントが放射線状に結合したものであってもよい。また、共役ジエンを含む重合体が少量のビニル芳香族の単量体とのランダム共重合体であってもよく、いわゆるテーパー型ブロック共重合体、すなわち1つのブロック内でビニル芳香族の単量体が漸増するものであってもよい。

【0110】ブロック共重合体の構造については特に制限はなく、(A-B)、型、(A-B)、-A型又は(A、B)、-C型のいずれであってもよい。式中、A

【0111】このようなブロック共重合体において、上記の非極性共役ジエン系共重体のかわりに、あるいはこれに加えて、前述の非極性 αーオレフィン系重合体を用いてもよく、非極性共役ジエン系重合体は αーオレフィン単量体を含んでいるものであってもよく、非極性 αーオレフィン系重合体は、共役ジエンの単量体を含んでいるものであってもよい。ブロック共重合体における各セ 50

22 グメントの**畳比や**好ましい態様についてはグラフト共重 合体に準じる。

【0112】この樹脂組成物、好ましくは特定の多相構造を示す熱可塑性樹脂(特に好ましくはグラフト共重合体)には、耐熱性を向上させるために、4-メチルペンテン-1の単量体を含む非極性 α -オレフィン系重合体を加えることが好ましい。なお、本発明では、4-メチルペンテン-1の単量体を含む非極性 α -オレフィン系重合体が化学的結合をすることなく樹脂組成物に含有されている場合もありうるが、このような場合には必ずしもその添加は必要とはされない。ただし、所定の特性を得るためにさらに添加してもよい。

【0113】 このような4-メチルペンテン-1の単量体を含む非極性 $\alpha-$ オレフィン系共重合体における4-メチルペンテン-1の単量体の割合は50重量%以上であることが好ましい。なお、このような非極性 $\alpha-$ オレフィン系共重体は、共役ジエンの単量体を含むものであってもよい。

【0114】特に、4-メチルペンテン-1の単量体を含む非極性α-オレフィン系共重合体としては、4-メチルペンテン-1の単量体の単独重合体であるポリ4-メチルペンテン-1であることが好ましい。

【0115】ポリ4-メチルペンテン-1は、結晶性のポリ4-メチルペンテン-1であって、プロピレンの2 量体である4-メチルペンテン-1をチーグラー・ナッタ系触媒等を用いて重合されるアイソタクチック・ポリ4-メチルペンテン-1が好ましい。

【0116】ポリ4-メチルペンテン-1と特定の多相構造を示す熱可塑性樹脂の割合は、特に限定はないが、耐熱性及び金属との接着性を満足するために、ポリ4-メチルペンテン-1の割合が10~90重量%であることが好ましい。ポリ4-メチルペンテン-1の割合が少ないと半田耐熱性が不足する傾向がある。またポリ4-メチルペンテン-1にかえて、共重合体を使用するときの添加量は、これに準じるものとすればよい。

【0117】この樹脂組成物(4-メチルペンテン-1の単量体を含む非極性 $\alpha-$ オレフィン系重合体を加えたものを含む)の軟化点は $200\sim260$ であり、適宜選択して用いることにより、十分な半田耐熱性を得ることができる。

【0118】この樹脂材料を所定形状にする成形方法としては、すでに述べたものもあるが、モールディング法、コンプレッション法、押し出し法などが挙げられ、公知の方法に準じ、樹脂材料の使用目的に応じ安価に成形できる方法を選択すればよい。

【0119】図3は本発明の他の実施形態におけるTE 01δ誘電体共振器の構成を概略的に示す分解斜視図である。

【0120】同図において、30はTE01δモードの 共振素子、31はその支持台、32はこの共振器が取り 付けられる据付け面をそれぞれ示している。

【0121】共振素子30は、図に示すように円柱形状であるか又は角柱形状に成形された焼結セラミック体からなっており、その中央には貫通孔300が同軸に形成されている。この共振器が $60\sim70\,\mathrm{GHz}$ 帯用であるとすると、共振素子30の外径は約 $0.6\sim0.7\,\mathrm{mm}$ 程度となる。

【0122】支持台31は、工具係合部310と、この工具係合部310から上方に伸長する2つの弾性係止片311及び312と、この工具係合部310から下方に同軸に伸長する雄ねじ部313と、工具係合部310の上端部に形成されている上側ストッパ114と、工具係合部310の下端部に形成されている下側ストッパ115とを可撓性を有する低誘電性高分子材料によって一体成形することにより構成されている。

【0123】工具係合部310は、本実施形態では六角 ナット形状に形成されており、スパナ等の取り付け工具 に係合して支持台31を軸回転させるように構成されて 20 いる。

【0124】なお、工具係合部310の形状は、六角ナット形状に限定されるものではなく、四角ナット、その他の角ナット、丸ナット等のナット形状であっても良いし、また、他の取り付け工具に係合して支持台31を軸回転させるための形状であれば良い。

【0125】上側ストッパ314(本発明の第1の肩部に対応)は、上面が平坦となっており工具係合部310の上端部から放射外方向に突出する3つの突出片から構成されている。この上側ストッパ314は、共振素子30の貫通孔300の内径より大きな外径又は横方向長さを有している。下側ストッパ315(本発明の第2の肩部に対応)も、下面が平坦となっており工具係合部310の下端部から放射外方向に突出する3つの突出片から構成されている。この下側ストッパ315は雄ねじ部313の外径より大きな外径又は横方向長さを有している。

【0126】なお、上側ストッパ314及び下側ストッパ315の突出片の数は上述のように3つに限定されるものではなく、2つ以上いくつであっても良い。ただし、円周方向に等間隔に配置されていることが望ましい。また、上側ストッパ314及び下側ストッパ315の各々を、全周に沿って突出する1つの部材で構成しても良い。

【0127】2つの弾性係止片311及び312の各々は、工具係合部310の上端より上方に伸長しており、放射外方向及び放射内方向に弾性で撓むように構成されている。弾性係止片311及び312の頭部には、共振素子30の貫通孔300に嵌合した際に、弾性係止片311及び312の放射外方向へ反発する弾性によって貫 50

24

通孔300の上側内縁301を下向きかつ放射外方向に押圧するための下向き傾斜面316及び317がそれぞれ設けられている。また、弾性係止片311及び312の先端部分は、その先端の径が貫通孔300の内径より小さいが、その下方では径が貫通孔300の内径よりや、や大きくなるように設定されている。ただし、共振素子30の貫通孔300への挿入を容易にするために、弾性係止片311及び312の先端部分はその頂端に行くほど放射内方向に向かう滑らかな曲面が形成されている。

【0128】なお、弾性係止片の数は上述のように2つに限定されるものではなく、3つ以上であっても良い。 ただし、円周方向に等間隔に配置されていることが望ま

【0129】雄ねじ部313は、据付け面32に形成されたねじ孔320に螺合できるように形成されている。

【0130】このような構造を有する支持台31と共振 素子30とを組み付ける場合は、支持台31の2つの弾 性係止片311及び312を共振素子30の貫通孔30 0へ下方から挿入する。

【0131】弾性係止片311及び312の先端の径が 貫通孔300の内径より小さいため、及び弾性係止片3 11及び312の先端部分が滑らかな曲面となっている ため、弾性係止片311及び312は貫通孔300へ容 易に挿入できる。挿入が進むに従って、弾性係止片31 1及び312は、貫通孔300の内面に押されて放射内 方向に撓み、反発する弾性によって貫通孔300の内面 を逆に押圧する。

【0132】弾性係止片311及び312の先端部分における最も径の大きい部分が貫通孔300を通り抜け、反対側に突出すると、弾性係止片311及び312の下向き傾斜面316及び317が、貫通孔300の上側内線301に当接し、これを前述した反発する弾性によって下向きかつ放射外方向に押圧する。このため、共振素子30は、弾性係止片311及び312の下向き傾斜面316及び317と上側ストッパ314の上面との間で挟まれて自動的にかつ強固に支持固結されることとなる。

【0133】下向き傾斜面316及び317によって下向きかつ放射外方向に押圧されるので、弾性係止片311及び312の寸法をさほど精密に設定する必要はない。即ち、上側ストッパ314の上面と下向き傾斜面316及び317の下縁との距離~上側ストッパ314の上面と下向き傾斜面316及び317の上縁との距離の範囲に共振素子30の厚みが入るように設定すれば強固な結合が行える。

【0134】支持台31と共振素子30とを組み付けてなる共振器を据付け面32に取り付けるには、支持台31の工具係合部310にスパナ等の取り付け工具を係合させ、雄ねじ部313をねじ孔320に挿入し、下側ストッパ315の下面が据付け面32に当接して止まるま

で支持台31を軸回転させて螺着する。

【0135】以上述べたように本実施形態によれば、共振素子30の貫通孔300内に弾性係止片311及び312を挿通させるだけで固結が自動的に行われるので、位置合わせも不要であり、60~70GH2帯用の極小の誘電体共振素子30であっても支持台31への組み付けが非常に容易となる。しかも、弾性係止片311及び312の下向き傾斜面316及び317が弾性によって貫通孔300の上側内縁301を下向きかつ放射外方向に押圧するようにしているので、これら係止片の寸法をさほど精密に設定しない場合でも隙間が発生せず確実なかつ強固な固定が期待できる。

【0136】本実施形態で支持台31の一体成形に用いている低誘電性高分子材料は、図1の実施形態の場合と同じであり、②誘電率が低くミリ波帯においても損失が小さいという優れた高周波特性を有する、②成形が容易である、③熱膨張係数が小さい、④接着剤による接着性が良いという利点を備えている。支持台31の成形にこのような低誘電性高分子材料を用いることにより、工具係合部310、弾性係止片311及び312、雄ねじ部313、上側ストッパ314及び下側ストッパ315等の複雑な形状を容易に一体成形で形成でき、しかも熱膨張が少なく、高周波特性の優れた誘電体共振器が得られるのである。

【0137】以上述べた実施形態は全て本発明を例示的に示すものであって限定的に示すものではなく、本発明は他の種々の変形態様及び変更態様で実施することができる。従って本発明の範囲は特許請求の範囲及びその均等範囲によってのみ規定されるものである。

[0138]

【発明の効果】以上詳細に説明したように本発明によれば、誘電体共振素子の貫通孔内に支持手段の複数の弾性係止片を挿入してその頂部を貫通孔の反対側へ突出させることにより、各係止片の下向き傾斜面が弾性によって貫通孔の上側内縁を下向きの放射外方向に押圧する。こ

れによって、誘電体共振素子は、支持手段の複数の弾性 係止片の下向き傾斜面と第1の肩部とによってを弾性挟 持され、支持手段と誘電体共振素子との固結が自動的に 行われる。共振素子の貫通孔内に支持手段の弾性係止片 を挿通させるだけで固結が自動的に行われるので、位置 合わせも不要であり、極小の誘電体共振素子であっても その支持手段への組み付けが非常に容易となる。しか

26

も、各係止片の下向き傾斜面が弾性によって貫通孔の上 側内縁を下向きの放射外方向に押圧するようにしている ので、係止片の寸法をさほど精密に設定しない場合でも 隙間が発生せず確実なかつ強固な固定が期待できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態におけるTE01δ誘電体 共振器の構成を概略的に示す分解斜視図である。

【図2】図1の実施形態における共振器を据付け面に取り付けた状態の軸断面図である。

【図3】本発明の他の実施形態におけるTE01δ誘電体共振器の支持台部分の構成を概略的に示す斜視図である。

0 【符号の説明】

10、30 TE01δモードの共振素子

11、31 支持台

12、32 据付け面

100、300 貫通孔

101、301 上側内縁

110、310 工具係合部

111、112、311、312 弹性係止片

113、313 雄ねじ部

114 上面

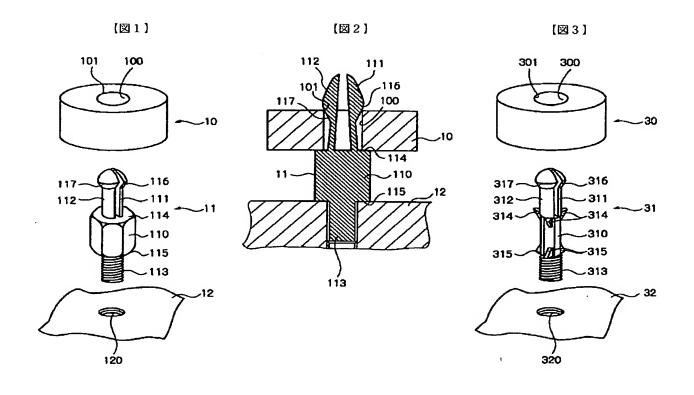
30 115 下面

116、117、316、317 下向き傾斜面

120、320 ねじ孔

314 上側ストッパ

315 下側ストッパ



フロントページの続き

(72) 発明者 味岡 恵理子

東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー ディーケイ株式会社内

(72) 発明者 遠藤 謙二

東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー ディーケイ株式会社内 Fターム(参考) 3J036 AA03 BA01 DB06 5J006 HC04 HC07 HC23 HC25 LA18 LA25